

GaAs pHEMT MMIC SPDT 匹配式开关, 0.1 - 20 GHz

F6

主要特点

全正电控制,集成 TTL,具有全关功能

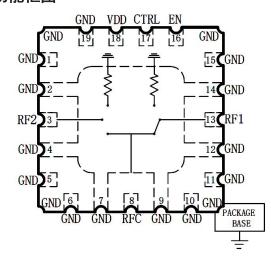
隔离度: 55 dB @ 20 GHz 插入损耗: 2.1 dB @ 20 GHz

匹配式设计

供电: +5 V @ 2 mA

陶封尺寸: 19Lead , 4mm×4mm QFN

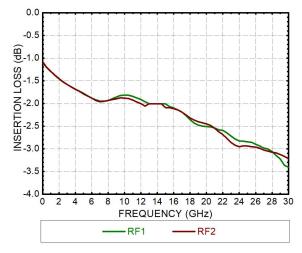
功能框图



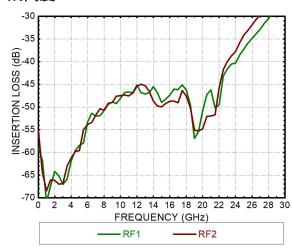
性能指标(T_A = +25°C, CTRL = 0/+3.3V, VDD=+5V)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	0.1 - 20			GHz
插入损耗		2.1		dB
隔离度		60		dB
回波损耗"打开状态"		20		dB
回波损耗"关闭状态"		15		dB
输入功率 1dB 压缩点@1-20GHz		24		dBm
开关切换时间		25		ns

插入损耗



隔离度

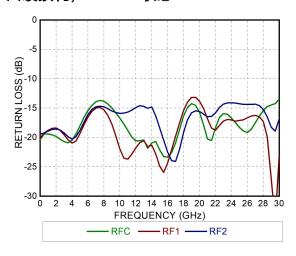


单位: mm

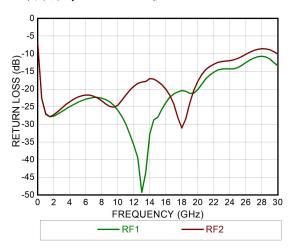


GaAs pHEMT MMIC SPDT 匹配式开关, 0.1 - 20 GHz

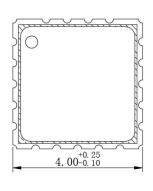
回波损耗。"ON"状态



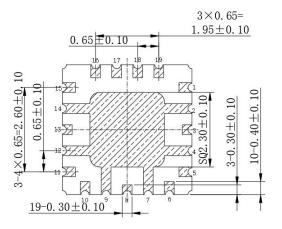
回波损耗, "OFF"状态



物理参数







注意事项:

- 1. 器件在干燥、氮气环境中存储;
- 2. 器件对静电敏感,在储存、运输、储存、装配和使用过程中注意防静电;
- 3. 所有接地引脚请连接 RF 地;
- 4. 该产品适用于回流焊贴装工艺,回流焊温度≤265℃,回流焊使用时需要做去金预处理;
- 5. 控制输入端建议串联 1K 欧姆以上的保护电阻。



GaAs pHEMT MMIC SPDT 匹配式开关, 0.1 - 20 GHz

F6

引脚描述

JIPTIMAL				
引脚序号	功能	描述		
3	RF2	该引脚是射频支路端口,需要外部加入隔直电容		
13	RF1			
8	RFC	该引脚是射频公共端口,需要外部加入隔直电容		
16	EN	EN=0V ,CTRL=0V ,则 RF1 为"ON"状态,RF2 为"OFF"状态; EN=0V ,CTRL=+3.3V ,则 RF1 为"OFF"状态,RF2 为"ON"状态 EN=+3.3V ,则 RF1 为"OFF"状态,RF2 为"OFF"状态;		
17	CTRL			
18	VDD	该焊盘为数字电路电源端,接+5V 电源电压		
其余	GND	必须连接至 RF/DC 地		
四角 GND 引脚及底 部中央焊盘	GND	四角 GND 引脚及底部中央焊盘必须连接至 RF/DC 地		

真值表

>				
功能	EN	CTRL		
RFC-RF1	0	0		
RFC-RF2	0	1		
全关	1	_		
"0" 电平范围: 0~0.8V,"1" 电平范围: 2.3~5V。				

极限参数

- 1. 电源电压: +6 V
- 2. 射频输入功率: +27 dBm
- 3. 储存温度: -65~+150°C
- 4. 工作温度: -55~+85°C